

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
747-7

1988

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2

1994-07

Amendement 2

**Dispositifs discrets et circuits intégrés
à semiconducteurs**

Septième partie:
Transistors bipolaires

Amendment 2

**Semiconductor discrete devices and integrated
circuits**

Part 7:
Bipolar transistors

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
47(BC)1335	47(BC)1337

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 12

CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTÉRAUX

2 Termes généraux

Remplacer le texte de cet article par le suivant:

2.1 Régions physiques spécifiques (d'un transistor à jonctions)

2.1.1 Région collecteur

Région physique conçue par le fabricant pour contenir la région collectrice en mode de fonctionnement normal et qui, dans un transistor discret simple, est accessible extérieurement par la borne de collecteur désignée.

2.1.2 Région émetteur

Région physique conçue par le fabricant pour contenir la région d'alimentation en mode de fonctionnement normal et qui, dans un transistor discret simple, est accessible extérieurement par la borne d'émetteur désignée.

2.1.3 Région base

Région physique située entre la jonction collecteur et la jonction émetteur, comprenant la région de commande et qui, dans un transistor discret simple, est accessible extérieurement par la borne de base désignée.

2.1.4 Jonction collecteur(-base)

Région de transition située entre la région collecteur et la région base.

2.1.5 Jonction émetteur(-base)

Région de transition située entre la région émetteur et la région base.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
47(CO)1335	47(CO)1337

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 13

CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS**2 General terms**

Replace the text of this clause by the following

2.1 Specific physical regions (of a junction transistor)**2.1.1 Collector region**

The physical region that is designed by the manufacturer to contain in the normal operating mode the collection region and, in a simple, discrete transistor, is externally accessible by the designated collector terminal.

2.1.2 Emitter region

The physical region that is designed by the manufacturer to contain in the normal operating mode the supply region and, in a simple, discrete transistor, is externally accessible by the designated emitter terminal.

2.1.3 Base region

The physical region located between the collector junction and the emitter junction and that contains the control region and, in a simple, discrete transistor, is externally accessible by the designated base terminal.

2.1.4 Collector(-base) junction

The transition region between the collector region and the base region.

2.1.5 Emitter(-base) junction

The transition region between the emitter region and the base region.

2.1.6 *Borne du collecteur*

Point de connexion spécifié, accessible extérieurement, relié à l'électrode collecteur et à la région collecteur.

2.1.7 *Borne de l'émetteur*

Point de connexion spécifié, accessible extérieurement, relié à l'électrode émetteur et à la région émetteur.

2.1.8 *Borne de base*

Point de connexion spécifié, accessible extérieurement, relié à l'électrode de base et à la région de base.

2.2 *Régions fonctionnelles spécifiques*

2.2.1 *Région collecteur fonctionnelle*

Région collecteur qui capte les porteurs de charge du courant principal de la région base fonctionnelle passant par la jonction (collectrice) située entre elle et la région base fonctionnelle.

NOTE – En mode de fonctionnement normal, cette région fonctionnelle est située dans la région collecteur et, en mode de fonctionnement inverse, dans la région émetteur.

2.2.2 *Région émetteur fonctionnelle*

Région d'alimentation qui fournit les porteurs de charge du courant principal à la région base fonctionnelle à travers la jonction (émettrice) située entre elle et la région base fonctionnelle.

NOTE – En mode de fonctionnement normal, cette région fonctionnelle est située dans la région émetteur et, en mode de fonctionnement inverse, dans la région collecteur.

2.2.3 *Région base fonctionnelle*

Région de commande traversée par le courant principal et dans laquelle la concentration des porteurs de charge du courant principal provient du courant de base qui y est appliqué.

2.2.4 *Région de charge d'espace collecteur(-base); couche de déplétion collecteur(-base)*

Région de charge d'espace située entre la région collecteur fonctionnelle et la région base fonctionnelle.

2.2.5 *Région de charge d'espace émetteur(-base); couche de déplétion émetteur(-base)*

Région de charge d'espace située entre la région émetteur fonctionnelle et la région base fonctionnelle.